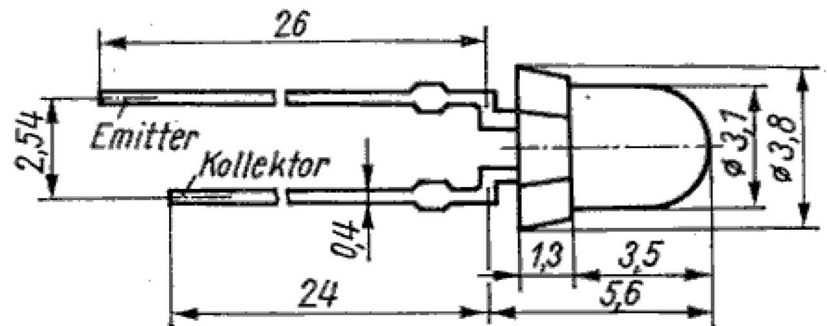


SP 213

Si-npn-Planar-Fototransistor in 3 mm Allplast-Linsenverpackung. Die spektrale Empfindlichkeit des SP 213 ist dem Einsatz in Verbindung mit GaAs-IRED angepaßt.

Bauform 12



Kennwerte bei ϑ_a 25 °C

Kollektorstrom

bei $E_v = 1\,000\text{ lx}$
 $U_{CE} = 5\text{ V}$

ungruppiert

SP 213 A

SP 213 B

SP 213 C

SP 213 D

I_c

min.

max.

1,0

1,0

1,6

2,5

3,6

— mA

2,0 mA

3,2 mA

5,0 mA

— mA

Kollektor-

Dunkelstrom

bei $E_e = 0$

$U_{CE} = 25\text{ V}$

I_{CO}

—

100 nA

Öffnungswinkel

Θ

60

— °

Schaltzeit

t_r, t_f

—

10 μs

Wellenlänge der

max. spektralen

Empfindlichkeit

λ_{max}

850

nm

Spektraler

Empfindlichkeits-

bereich

$\Delta\lambda$

450 ... 1 050

nm

Kollektor-Emitter-

Spannung

U_{CEO}

50

V

Emitter-Kollektor-

Spannung

U_{ECO}

7

V

Gesamtverlust-

leistung

P_{tot}

100

mW

Betriebstemperaturbereich ϑ_a

—40 ... +85

°C

Lagerungstemperatur-

bereich

ϑ_{stg}

—50 ... +100

°C